






	<h2>SIHP33N60E-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP33N60E-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP33N60E-GE3.pdf 2.SIHP33N60E-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 7885 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP33N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7885 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3508pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Bulk

SIHP33N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHP33N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP33N60E-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP33N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO- 220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>
 <p>SIHP33N60EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO- 220-3</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP35N60E Vishay Precision Group SIHP35N60E vishay</p>	 <p>SIHP30N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

SIHFL11N50A	SIHG16N50C-E3	SIHG16N50C-E3	SIHG17N60D	SIHG20N50C
SIHG22N60S-E3	SIHG30N60E	SIHG33N60E	SIHG47N60E-E3	SIHG47N60E-E3
SIHG47N60E-GE3	SIHG47N60E-GE3	SIHG47N60S-E3	SIHG70N60EFEF-GE3	SIHG73N60E-GE3
SIHG73N60E-GE3	SIHP10N40D	SIHP12N50C-E3	SIHP12N50C-E3	SIHP12N60E-E3
SIHP12N60E-E3	SIHP12N60E-GE3	SIHP12N60E-GE3	SIHP12N65E	SIHP14N50D
SIHP15N60E-E3	SIHP15N60E-E3	SIHP15N65E	SIHP16N50C-E3	SIHP16N50C-E3
SIHP17N60D-E3	SIHP17N60D-E3	SIHP18N50C-E3	SIHP18N50C-E3	SIHP22N60S-E3
SIHP30N60E-E3	SIHP30N60E-E3	SIHP30N60E-GE3	SIHP30N60E-GE3	SIHP30N60E-GE3
SIHP33N60E-GE3	SIHP5N50D-E3	SIHP5N50D-E3	SIHP6N40D	SIHP8N50D-E3
SIHP8N50D-E3	SIHU3N50D-E3	SIHU3N50D-E3	SIHW30N60E-GE3	SIHW30N60E-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited